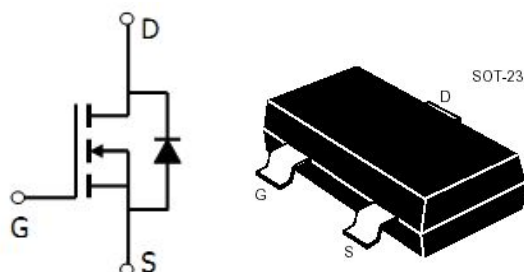


SOT-23 場效應晶體管(SOT-23 Field Effect Transistors)


N-Channel Enhancement-Mode MOS FETs

N 沟道增强型 MOS 场效应管

■ MAXIMUM RATINGS 最大額定值

Characteristic 特性參數	Symbol 符號	Max 最大值	Unit 單位
Drain-Source Voltage 漏極-源極電壓	BV_{DSS}	60	V
Gate- Source Voltage 柵極-源極電壓	V_{GS}	± 20	V
Drain Current.continuous 漏極電流-連續	I_{DR}	2.6	A
Drain Current-pulsed 漏極電流-脉冲	I_{DRM}	6	A

■ THERMAL CHARACTERISTICS 熱特性

Characteristic 特性	Symbol 符號	Max 最大值	Unit 單位
Total Device Dissipation 總耗散功率 $T_A=25^\circ\text{C}$ 環境溫度為 25°C Derate above 25°C 超過 25°C 遞減	PD	1000 3.8	mW mW/ $^\circ\text{C}$
Thermal Resistance Junction to Ambient 熱阻	$R_{\theta JA}$	150	$^\circ\text{C}/\text{W}$
Junction and Storage Temperature 結溫和儲存溫度	T_J, T_{stg}	150 $^\circ\text{C}$, -55to+150 $^\circ\text{C}$	



■ **DEVICE MARKING 打標**

GM2308=E8

■ **ELECTRICAL CHARACTERISTICS 電特性**

($T_A=25^{\circ}\text{C}$ unless otherwise noted 如無特殊說明，溫度為 25°C)

Characteristic 特性參數	Symbol 符號	Min 最小值	Typ 典型值	Max 最大值	Unit 單位
Drain-Source Breakdown Voltage 漏極-源極擊穿電壓($I_D=250\mu\text{A}, V_{GS}=0\text{V}$)	BV_{DSS}	60	—	—	V
Gate Threshold Voltage 柵極開啓電壓($I_D=250\mu\text{A}, V_{GS}=V_{DS}$)	$V_{GS(th)}$	1	—	3	V
Diode Forward Voltage Drop 內附二極管正向壓降($I_{SD}=1\text{A}, V_{GS}=0\text{V}$)	V_{SD}	—	—	1.5	V
Zero Gate Voltage Drain Current 零柵壓漏極電流($V_{GS}=0\text{V}, V_{DS}=60\text{V}$)	I_{DSS}	—	—	1	μA
Gate Body Leakage 柵極漏電流($V_{GS}=\pm 20\text{V}, V_{DS}=0\text{V}$)	I_{GSS}	—	—	± 100	nA
Static Drain-Source On-State Resistance 靜態漏源導通電阻($I_D=2.6\text{A}, V_{GS}=10\text{V}$) ($I_D=2\text{A}, V_{GS}=4.5\text{V}$)	$R_{DS(ON)}$	—	—	100 130	$\text{m}\Omega$
Input Capacitance 輸入電容 ($V_{GS}=0\text{V}, V_{DS}=25\text{V}, f=1\text{MHz}$)	C_{ISS}	—	—	550	pF
Common Source Output Capacitance 共源輸出電容($V_{GS}=0\text{V}, V_{DS}=25\text{V}, f=1\text{MHz}$)	C_{OSS}	—	—	125	pF
Turn-ON Time 開啓時間 ($V_{DS}=30\text{V}, I_D=200\text{mA}, R_{GEN}=25\Omega$)	$t_{(on)}$	—	—	40	ns
Turn-OFF Time 關斷時間 ($V_{DS}=30\text{V}, I_D=200\text{mA}, R_{GEN}=25\Omega$)	$t_{(off)}$	—	—	80	ns

1. FR-5=1.0×0.75×0.062in.
2. Alumina=0.4×0.3×0.024in.99.5%alumina.
3. Pulse Width≤300 μs ; Duty Cycle≤2.0%.